

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 56-018336

(43)Date of publication of application : 21.02.1981

(51)Int.Cl. H01J 1/30

(21)Application number : 54-092672

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 23.07.1979

(72)Inventor : FUTAMOTO MASAOKI
YUHTO ISAMU
KAWABE USHIO

(54) ELECTRON EMISSION CATHODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain easily a high density and uniform electron beam by specifically designating the crystal direction of a needlelike chip axis and holding the needlelike chip on a supporter in order to facilitate cleaning the surface of the needlelike chip.

CONSTITUTION: The needlelike chip 1, consisting of a carbide or nitride single crystal whisker having a sodium chloride type crystal structure, is held by the conductive support 2. The orientation of the crystal axis of the needlelike chip 1 is designated $\langle 111 \rangle$. In an electron emission cathode with such a constitution, the cleaning of the needlelike chip 1 can be performed by heating it at a high temperature under a high vacuum.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998.2000 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭56-18336

⑫ Int. Cl.³
H 01 J 1/30

識別記号

庁内整理番号
6377-5C

⑬ 公開 昭和56年(1981)2月21日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 6 頁)

⑭ 電子放射陰極

地株式会社日立製作所中央研究
所内

⑯ 特 願 昭54-92672

⑰ 発 明 者 川辺 潮

⑱ 出 願 昭54(1979)7月23日

国分寺市東窓ヶ窪1丁目280番
地株式会社日立製作所中央研究
所内

⑲ 発 明 者 二本正昭

⑳ 出 願 人 株式会社日立製作所

国分寺市東窓ヶ窪1丁目280番
地株式会社日立製作所中央研究
所内東京都千代田区丸の内1丁目5
番1号

㉑ 発 明 者 由比藤男

㉒ 代 理 人 弁理士 澤田利幸

国分寺市東窓ヶ窪1丁目280番

明 細 書

発明の名称 電子放射陰極

特許請求の範囲

1. 塩化ナトリウム型結晶構造を有する炭化物または窒化物の単結晶ハイクからなる針状チップおよび該針状チップを保持する支持体とを有し、且つ該針状チップの軸の結晶方位が $\langle 111 \rangle$ であることを特徴とする電子放射陰極。
2. 上記単結晶ハイクからなる針状チップが TiC、ZrCもしくはHfCからなることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電子放射陰極。
3. 上記支持体がガラス状炭素からなることを特徴とする特許請求の範囲第1項もしくは第2項記載の電子放射陰極。
4. 上記針状チップと上記支持体とが溶合材により結合されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項もしくは第2項記載の電子放射陰極。
5. 上記支持体さらに上記結合材がガラス状炭素よりなることを特徴とする特許請求の範囲第1項

(1)

4項記載の電子放射陰極。

6. 上記結合材を構成する上記ガラス状炭素が炭化物炭素および窒化物炭素の少なくとも一種を含むことを特徴とする特許請求の範囲第5項記載の電子放射陰極。

発明の詳細な説明

本発明は、電子顕微鏡などの電子ビーム応用装置に有用な電界放射陰極 (F E陰極) に関するものである。

F E陰極は先端曲率が1000Å程度の針状チップ先端に電界を集中し、電界の作用で電子を引き出すものである。さらにF E陰極は動作に先立つて針状チップ表面の不純物を除去したり、針状チップ表面の形状を磨るために2000℃以上の高温に加熱される。このようにF E陰極の針状チップの材料として必要を条件は、電気伝導性があり、高融点、高硬度で耐イオン衝撃性が大きく、腐食性が低いことである。加えて、針状チップへの加工性が良く、電子ビームが針状チップの軸方向に有効に放射されることが必要である。

(2)

従来、P型電極として使用された材料としては、 W の諸条件をほぼ満足する、 W と C の炭化物である。これらの材料の中で専ら採用に供せられているのは加工性の優れた W だけである。 W を用いたP型電極では、針状チップの軸方向への電子放射密度の大きい $<110>$ や $<100>$ 方位を軸方向として得た単結晶の針状チップが利用されている。このW-C電極は 10^{-4} Torr以下の超高真空中でなければ安定に動作せず、さらに放射電流が専ら急激な変化を示すため、P型電極の使用上、各種の制約がある。すなわち、電子ビームを放射開始した直後では放射電流の急激な変化が大きいので電子ビームを利用して、さらに長時間経過すると真空中の残存ガスのイオン・スプラッシュで針状チップ表面が汚れて電子ビームが変動するため、フラッシュにより針状チップ表面を再処理する必要がある、といった問題点があった。本発明は前記従来技術の問題点を解消した、便宜なP型電極の提供を目的とするものである。

(3)

を有すればよいが、通常は 0.1μ 以上で製造が容易である。長さの上限はその電極の通常の設計条件により定まる。

支持体の材料は普通は導電性の材料であり、当技術分野で周知のもの、例えば高融点金属、炭化物、窒化物、炭素等が用いられるが、特にガラス状炭素が好ましい。

電子放射材料で構成された針状チップと導電性支持体との組合せ方にはスポット溶接、機械的圧着、接合材の使用等が知られており、本発明の電子放射電極はそのいずれでもよいが、特に接合材の使用が好結果を示す。接合材としてはガラス状炭素が好ましく、特に粉末状の炭化物もしくは炭化物、例えば TiC 、 ZrC 、 HfC 、 NbC 、 BaC 、 ZrB 、 TiB 、 BaSi 、 LaB 等を含むガラス状炭素が好ましい。

以上のよう、本発明による電子放射電極は針状チップ、導電性支持体の他に、両者を結合する結合材を有することが望ましい。このよう、針状チップ、導電性支持体ならびに結合材を有する

(5)

特開56-18336(2)

上記目的を達成するため、本発明による電子放射電極は、塩化ナトリウム(NaCl)の結晶構造を有する炭化物または炭化物の単結晶ホイスカからなる針状チップおよび該針状チップを保持する支持体とを有し、且つ該針状チップの軸の方位を $<111>$ とするものである。

上記単結晶ホイスカは塩化ナトリウム結晶構造を有する炭化物または炭化物からなり、例えば Ti 、 Zr もしくは Hf の炭化物あるいは炭化物、炭化炭素の2種もしくは3種の固溶体、または炭化炭素の2種もしくは3種の固溶体等からなるものである。

一般にホイスカの直径は 1000Å ~ 500Å の範囲で各種のものがあるが、本発明の電子放射電極はそのいずれの直径のホイスカを用いてもよい。しかし、ホイスカのより好ましい直径は $20\sim 150\text{Å}$ の範囲であり、この範囲であれば炭化炭素の製造に於いて取扱いが特に容易である。また、上記ホイスカは導電性支持体上にマウントして且つその先端を針状に成形するのに十分を長さ

(4)

電子放射電極の構造およびその製造方法の詳細については、日本特許出願明細書、特開52-43848に記載されており、そのまゝ本発明の電子放射電極に適用できる。

上記のように、本発明による電子放射電極は単結晶ホイスカからなる針状チップの軸方向が $<111>$ なる方位を有するものであるが、これはこのような方位を有するホイスカは育成が容易であり且つ特に強い電子ビームが放射されるからである。

ところで、塩化ナトリウム(NaCl)の結晶構造を持つ Ti 、 Zr 、 Hf 等の炭化物は良好な電気伝導性を示し、融点も高く、高真空で、高電圧が低く、射イオン衝撃性が W よりもはるかに大きい。さらに、炭化物は真空中の残留ガス(H_2 、 H_2O 、 CO など)との相互作用が W などの純金属に比べて小さいため、安定な電子ビームを放射するP型電極材料となる。しかし、これらの炭化物は結晶育成そのものが困難なうえ、極めて高いので針状チップに加えては難く、また、これらの針状チップ

(6)

を保持しかつ高温に加熱できる状態の構造が開示されていなかっただけ、その電子ビーム放射特性は明らかにされていなかっただけ、とくにこれらの炭化物の単結晶を針状チップに使用したとき、電子ビームが放射方向に有効に放射される単結晶の方位すらも知られていなかっただけ。

P層は使用の前に炭素炭素の不純物を除去するため2000℃以上の高温に加熱される。このとき、針状チップ先端の形状は炭素原子の移動を配列、あるいは層間のため変化する。この変化は結晶構造に依存して起こる。P層の針状チップ先端から放射される電子ビームの分布は、結晶面の仕事関数と形状に依存し、仕事関数が低くてテーパー状の先端形状の局所曲率が小さい領域ほど高密度な電子ビームを放射することができる。したがって望ましい針状チップの方位として、上記領域が針状チップ先端にくるように選ぶことが必要である。このようにすれば、電子ビームの組合せも容易になり、装置の設計上都合がよい。

本発明者らの実験によれば、N₂C₂型の結晶層

(7)

は80~95vol%とした。X線回折による分析ではT₁C₂の組成はT₁、Cであった。ホイムカーの成長方向は4種類あり、〈100〉と〈111〉、〈110〉、〈112〉であった。両者の二つの方位のものが優先的に成長した。ついで、フランドリンの幅1.0mm、厚さ0.4mm、長さ1.5mmのフィラメントの中央部に、炭化のフランドリンに325ノットスのT₁C₂粉末を約40vol%加えた混合材でT₁、Cホイムカーを塗布した。塗布層を200℃で充分に加熱して硬化させた後、これを平度のグラフアイトポートに入れ、グラフアイトポートで押えつけながら、真空中で1700℃まで加熱して炭化した。グラフアイトポートで押えながら加熱したのは側面フィラメントが炭化すると変形するのを防止するためである。フィラメントと混合材を用いたフランドリンは炭化するとともに極めて緻密で機械的強度が大きいガラス状炭素に変化した。ガラス状炭素は通常の炭素材料に比べて比重が高く、熱伝導率が小さいので、電子放射管の導電性フィラ

(8)

特開56-18336(3)

造を持つ炭化物の針状チップで電子ビームの放射強度を測定すると〈111〉方位に特に強い電子ビームが放射されることが明らかにされた。

〈111〉なる結晶方位の端方向を持つ炭化物の針状チップを用いたP層は電子ビームを極めて有効に利用できるもので、実用上、有用な電子放射管となり得るものである。

以上、主として炭化物について述べたが、炭化物についても同様のことが言える。

以下、本発明を実施例を参照して詳細に説明する。

実施例 1

電極炭素炭化によつてT₁C₂のホイムカーを育成した。1300~1400℃に加熱した炭化炉内に炭素として燃料もしくはムライトを置き、T₁C₂、CH₄、およびH₂から成る混合ガスを約2時間流すことによつて、長さ50~100mmで直径が約0.1mmのT₁C₂ホイムカーを育成することができた。混合ガス中のT₁C₂とCH₄との混合比T₁C₂/CH₄は体積比で0.7~0.8であり、H₂は金ガ

(9)

メントとして使用したとき針状チップを有効に加熱する上で望ましいものである。ついで、T₁、Cホイムカーを溶解と炭化の混合比が3:5の溶解液からなる電解液中で約5Vの直流電圧下の電解槽中で針状加工し、針状チップがT₁、Cホイムカーから成るP層を形成させた。第1図(a)はこのようにして作成した電子放射管の形状を示す断面図である。1は〈111〉方位を持つ針状チップ、2は導電性支持体、3は混合材である。

このような方法で作った、〈100〉と〈111〉の2種類の結晶方位を持つT₁、CのP層を真鍮板に取付けて、電子ビームの放射パターンを測定した。10⁻⁴Torrの真空中でP層の炭素フィラメントに通電し、2000℃以上の温度にT₁、C針状チップを加熱した後、P層に負の高電圧を印加し、対向して設けた蛍光面上に電子ビームの放射パターンを投影させた。この結果、第2図に示すように、〈100〉方位のT₁、CのP層からは中央部が暗く周辺部が明るい放射パターン(a)が、一方、〈111〉方

(10)

位の $Ti_{1-x}C_x$ のF区層の場合には中央部が異なる3回軸対称の放射パターンが得られた。放射パターンにおいて異なる部分は電子ビームが高密度に放射されていることに対応しており、 $\langle 111 \rangle$ 方位の $Ti_{1-x}C_x$ 針状ナップからはその軸方位に電子ビームが有効に放射されていることが確認された。第3図(4)、(5)において (100) 、 (110) 等の記号はその部分の電子放射に寄与している結晶面を示す。また、放射された電子ビームの安定度は同じ条件で測定したW-F区層の倍以上であった。さらに、電子線露光の寿命が約50%長くなる効果もあつた。

実施例 2

1300~1500℃に加熱した電気炉内に、基板として黒鉛とNiもしくは黒鉛とAlを置き、 ZrC 、 CH_4 および H_2 の混合ガスを3~5時間通入することによって基板上に太さ15~100μmで長さ3~4mmの ZrC ハイスカーを成長させた。混合ガス中の ZrC と CH_4 との混合比 ZrC/CH_4 は体積比で0.9~1であり、 H_2 は

(11)

ハイスカーを用いたF区層は放射にも強く、針状ナップが破壊し難いため、電子線露光の寿命が倍以上伸びる効果があることがわかった。

実施例 3

実施例2と同様にして、 HfC 、 H_2 および CH_4 を用いた気相成長法により HfC のハイスカーを育成した。ハイスカーの育成温度は1500~1800℃で、育成時間は4時間である。この結果、太さ約10μmで長さ3~3mmの HfC ハイスカーが得られた。X線回折によると HfC ハイスカーの結晶は $Hf_{1-x}C_x$ であり、ハイスカーの成長方向は $\langle 111 \rangle$ であった。ついで、実施例1と同様の方法で $Hf_{1-x}C_x$ ハイスカーを炭素フィラメントに固定した。実施例1と同様にして、ハイスカーの先端部を特製の電解液中で電解装置により針状ナップに加工してF区層を作製した。 $\langle 111 \rangle$ 方位の $Hf_{1-x}C_x$ ハイスカーを用いたF区層の電子ビーム放射パターンは第1図(4)に示した放射パターンと類似であり、針状ナップの軸方位に高密度の電子ビームが放射されることが

(12)

特開56-18336(4)

全ガス量の約95%とした。ハイスカーの方位は $\langle 100 \rangle$ と $\langle 111 \rangle$ の2種類あり、 ZrC のハイスカーの組成は $Zr_{1-x}C_x$ であつた。幅1mm厚さ0.3mm、長さ10mmのカーボンシートの中に、担持材として炭化のフラン樹脂に-325メッシュのB、C粉末を30%添加した状態で $Zr_{1-x}C_x$ のハイスカーを固定した。混合ガスを十分還元させた後、実施例1と同様な方法で接合部を炭化した。実施例1と同様に、 $Zr_{1-x}C_x$ ハイスカーを特製の電解液を用いて、電解装置により針状に加工した。

$Zr_{1-x}C_x$ のF区層の電子ビーム放射パターンは、第3図に示した $Ti_{1-x}C_x$ の放射パターンと類似であり、 $\langle 111 \rangle$ 方位の針状ナップからは軸方位にもつとも有効に電子が放射されることがわかった。この $\langle 111 \rangle$ 方位の $Zr_{1-x}C_x$ をエッジとしたF区層を、W-F区層を用いた電子線露光の電子線源と交換して使用したところ、W-F区層を用いた場合に比べて寿命が向上し、電子線露光の像の質が向上した。さらに $Zr_{1-x}C_x$

(13)

がわかった。また、電子ビームの安定度、電子線露光の寿命が著しく改善された。

実施例 4

第3図に示す形状の導電性支持体12を用いたCと以外に実施例1と同様に、軸方向が $\langle 111 \rangle$ なる結晶方位の $Ti_{1-x}C_x$ 単結晶ハイスカーを針状ナップとしたエッジを有する電子放射層を作製し、その特性を調べたところ、実施例1と同様の結果が得られた。第3図において、11は針状ナップ、12は接合材である。

以上の実施例で示したように、 NiC 等の結晶構造を持つ TiC 、 ZrC および HfC の場合、いずれも $\langle 111 \rangle$ なる結晶方位の軸を持つ針状ナップを用いることによって、軸方位に高密度な電子ビームを放射させるF区層を製造できることがわかる。なお、第1図(4)、(5)の高倍率をつた電子ビーム放射パターンの中央から照準して、 $\langle 111 \rangle$ 方位以外の $\langle 331 \rangle$ 、 $\langle 441 \rangle$ などの方位にも強い電子ビームが放射されることがわかる。しかし、 $\langle 331 \rangle$ 、 $\langle 441 \rangle$ などの

(14)



高次の指数を持つ方位を軸とするカイミカは作成することが実質上困難である。従い、薄板法で単結晶を作つても、これらの炭化物は非常に脆く、へき開し易いので、特定の方位のチップに切出すのは非常に困難である。

また実施例に述べた NiC 系の結晶構造の炭化物は、 $TiC-ZrC$, $TiC-HfC$, $TiC-NbC$ などの合金固溶体を作ることができ、これらの針状チップについても同様の効果は期待される。

また本発明の電子放射装置の使い方に於いても、たとえ P 層を加熱すると針状チップの表面に吸着するガス成分の量が減少し、 10^{-7} Torr のオーダの真空中に於いても放射電流がより安定になることから、このような $Thermal$ P 層電極が使われるが、本発明の電子放射装置は高真空に連続加熱しても $Thermal$ P 層電極を越すことなくしかも耐熱し難いので、電子ビームを安定に取り出すのに非常に都合がよく、とくに顕著な効果をもっているものである。同様のことは強化

(15)

第2図(a)は針状チップとして $\langle 100 \rangle$ なる結晶方位が軸方向である Ti_2NiC カイミカを用いた電子放射装置の電子ビーム放射パターンであり、第3図(a)はその軸方向が $\langle 111 \rangle$ なる結晶方位の場合の電子ビーム放射パターン、第3図は本発明の他の実施例における電子放射装置を説明する鳥瞰図である。

各図において、1および11は針状チップ、2および12は基盤支持体、3および13は接合部である。

代理人 弁護士 藤田利幸

(17)

特開昭56- 18336 (S)

物についても言えるのである。

したがって、針状チップの中心軸方向から高密度の均一な電子ビームが得られるためには、 NiC 結晶構造の炭化物もしくは炭化物単結晶カイミカの成長方位のうち、 $\langle 111 \rangle$ 方位の端をもつ電子放射装置が最も望ましい。この $\langle 111 \rangle$ という特定方位に、端面の半分以下の低真空で加熱するに、通常の大きさに成長させた針状電極を、ガラス状反応の導電性支持体に保持せしめた構造にすることによって、本発明の電子放射装置は高真空中で高真空に加熱して針状電極の活性化を行なう事が可能になり、あるいは $Thermal$ P 層電極として使えるようになり、高密度の均一な電子ビームを容易に得ることが出来るようになるので、本発明は電子ビーム応用装置に於いて、輝度、分解能の向上などの効果が得られる。故に、本発明は実用上有用なものである。

図面の簡単な説明

第1図(a)は本発明の一実施例における電子放射装置を説明する鳥瞰図、第1図(b)はその断面図、

(18)

第1図

(a)



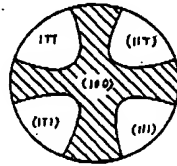
(b)



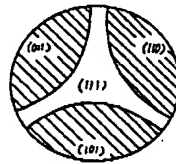
第 2 图

特图 56-18336 (6)

(a)



(b)



第 3 图

